## 横琴粤澳深度合作区经济发展局文件

粤澳深合经发通〔2025〕19号

### 关于印发《横琴粤澳深度合作区进一步促进集 成电路产业发展若干措施实施细则》的通知

#### 各有关单位:

《横琴粤澳深度合作区进一步促进集成电路产业发展若干措施实施细则》已经合作区执委会会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请径向合作区经济发展局反映。

横琴粤澳深度合作区经济发展局 2025年5月30日

#### 第3/2025号经济发展局规范性文件

### 横琴粤澳深度合作区进一步促进集成电路产业 发展若干措施实施细则

#### 目 录

第一章 总则

第二章 企业奖励

第三章 人才奖励

第四章 平台补贴

第五章 粤澳协同奖励

第六章 监督管理

第七章 附则

第一章 总 则

### 第一条 制定目的

为落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,推进横琴粤 澳深度合作区(以下简称合作区)集成电路产业高质量发展,有 效实施《横琴粤澳深度合作区进一步促进集成电路产业发展若干 措施》,特制定本实施细则。

## 第二条 定义

为适用本细则的规定,下列用词的含义为:

- (一)新增实缴出资,是指按照企业章程、合同或者协议的 约定,实际新增投入企业的资本总额。
  - (二)重点支持领域,是指以下方面:
  - 1.CPU、GPU及用于大模型和 HPC 场景的 AI 芯片;
- 2.先进存储器(HBM、DRAM、3DNAND 和 MRAM、RRAM等新兴存储器);
  - 3.采用五十五纳米以下制程流片的数模混合/模拟芯片;采用

九十纳米以下制程流片的车规级芯片;

- 4基带芯片、光通信芯片、传感器芯片、存储主控芯片等重点发展方向的芯片;
- 5.采用 RISC-V 架构, 面向工业、汽车、通信、数据中心场景的芯片;
- 6.采用 GaAs、GaN、SiC 化合物半导体工艺流片的功率或射频芯片;
- 7.采用 SOI 制造工艺流片的芯片;采用 BCD 制造工艺流片的芯片;
- 8.2.5D/3D 封装、晶圆级封装(WLP)、倒装芯片封装(Flip Chip)、多芯片封装(MCP)、芯粒(Chiplet)、系统级封装(SiP)、板级封装(PLP)、玻璃基封装、凸块(Bump)工艺、硅通孔(TSV)工艺以及重布线层(RDL)工艺的集成电路先进封装的研发技术;
- 9.硅片制造设备、掩膜制造设备、光刻设备、扩散及离子输入设备、薄膜生长及沉积设备、等离子体刻蚀设备等集成电路制造、封装测试、检测环节关键设备(含核心零部件、软件);半导体用硅晶圆和硅基材、化合物半导体晶圆、掩膜版、光刻胶、溅射靶材、封装基板等材料研发和生产。
- (三)专业投资机构,是指近五年入选以下任一榜单的机构 投资者、集成电路上市公司、各级政府投资基金以及合作区在中 国证券投资基金业协会备案的澳资私募基金(澳门居民或者在澳

门依法设立的法人持股比例合计须不低于百分之二十五):

- 1.投中网投中榜;
- 2.清科集团年度排名榜单;
- 3.母基金周刊(FOFWEEKLY)年度排行榜;
- 4.36 氪中国股权投资机构年度名册;
- 5.获得 IC 风云榜投资机构奖。
- (四)产业化投入(不含地价),是指申请单位自其在合作 区设立(包括新成立或迁入)之日起至申请年上一年度在合作区 的累计产业化投入金额,包括以下费用:
- 1.固定资产投入(不含软件购置费用,与设备不可分割的操作系统除外),具体定义以财政部颁布的《企业会计准则第4号-固定资产》(财会[2006]第3号)为准;
  - 2.购置设备的费用;
  - 3.购置合作区楼宇的费用;
  - 4.合作区办公、研发场地的装修费用(申请单位投入)。
- (五)净化车间,是指为了保证生产工艺的纯净度,控制空气中粉尘、微生物、有毒有害气体等污染物的浓度,从而达到一定洁净度标准的工作区域。
- (六)多项目晶圆(MPW),是指将多个具有相同工艺的 集成电路设计放在同一晶圆片上流片加工,按面积分担流片费 用,以降低新产品开发的成本和风险。
  - (七)首轮工程流片,是指集成电路企业对其研发的新型号

芯片与芯片制造企业、代流片企业或全资子公司开展产品量产前的全掩膜板(Full Mask)流片,并就对应型号芯片首次签订流片合同。

- (八) IP, 是指已验证的、可以重复使用的具有某种确切功能的集成电路设计模块,全称为 Intellectual Property(知识产权)。
- (九)车规级芯片,是指通过国际汽车电子协会车规级产品测试标准系列(AEC-Q系列)、汽车质量管理体系标准(IATF 16949)、道路车辆功能安全标准(ISO 26262)等汽车电子车规级认证的芯片,其中,AEC-Q系列认证包括 AEC-Q100(IC)、AEC-Q101(分立器件)、AEC-Q102(光电器件)、AEC-Q103(MEMS 传感器)、AEC-Q104(多芯片模组)、AEC-Q200(被动组件)可靠度标准认证。
- (十)自投研发费用,是指企业以自有资金(即不含企业所获得的国家、广东省、合作区无偿资助类财政资金)进行研发活动,按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 40号)、《财政部 税务总局 科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税〔2018〕64号)等文件规定归集的研究开发费用。国家有关文件有调整的,从其规定。

(十一)集成电路公共服务平台,是指国家、广东省、合作

区政府部门批准建设或认定的公共服务平台。

(十二) EDA,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计,全称为 Electronic Design Automation (电子设计自动化)。

(十三)研发人员,是指取得全日制学士及以上学位,所学专业学科门类为理学、工学,且从事集成电路产品架构研发、前端/后端设计、供应链、生产、FAE、测试、质量管理等相关部门的技术岗位者。

(十四)实地研发人员人数,按照以下标准统计:

- 1.与所在单位签订全职劳动合同,在所在单位缴纳社保或个人所得税(职业税),且上一年度在合作区或澳门实地办公的天数不少于年度实际工作天数的一半;
- 2.实地研发人员人数以上一年度十月、十一月、十二月满足以上实地办公条件的研发人员数量的月末平均数计算。合作区经济发展局有权对申请单位实际研发人员人数进行核实;
- 3.与合作区企业具有关联关系的澳门公司满足以上条件的 研发人员数量可计入其合作区关联企业的实地研发人员人数。

(十五)澳门居民,是指澳门永久性居民和非永久性居民。

(十六)澳门高校,是指根据澳门特别行政区第 18/2018 号行政法规《高等教育规章》批准设立的高等院校,包括澳门大学、

澳门科技大学、澳门理工大学、澳门旅游大学、澳门城市大学、圣若瑟大学、澳门镜湖护理学院、澳门管理学院、中西创新学院。

(十七)澳资企业,是指投资人为澳门居民或者在澳门依法设立且从事经营不少于两年的法人,且持股比例合计不低于百分之二十五。澳门居民和澳门法人的持股方式包括直接持股和间接持股,但不含股权代持。

(十八)与合作区企业具有关联关系的澳门公司,是指在澳门依法设立,依法缴纳税款(包括但不限于所得补充税、营业税)或依法免税的公司,满足以下任一条件:

- 1.合作区企业直接持有该公司百分之五十以上的股份(不含代持);
- 2.该公司直接持有合作区企业百分之五十以上的股份(不含代持);
- 3.该澳门公司与合作区企业(两家企业员工应至少有百分之八十不相同)同属于一个集团,且该集团分别持有(不含代持,包括穿透持股的方式)这两家企业各自百分之五十以上的股份。
- (十九)模拟芯片设计企业,是指专门从事处理连续函数形式模拟信号的集成电路设计、研发和销售企业,产品类别包括信号链芯片、电源管理芯片、时钟芯片、模拟计算等芯片。
- (二十)"不低于""不少于""不超过""以上""以下"是指包括本数的数目。

(二十一)本细则所指金额均为人民币。

(二十二)申请单位,是指企业、科研机构或组织。

## 第三条 适用主体

本细则适用于注册地、税务征管关系、统计关系在合作区, 具有独立法人资格,具备规范的财务管理制度,在合作区实质性 运营,且满足下列条件之一的企业、机构及组织:

- (一)主营业务符合《适用主营业务目录》(见附件)的企业;
  - (二)提供相关集成电路产业服务的企业、机构及组织;
  - (三)在合作区开展研究和成果转化的科研机构。

实质性运营认定标准按照第 2/2023 号执行委员会规范性文件《横琴粤澳深度合作区企业实质性运营认定规则》相关规定执行。

### 第四条 申请奖补登记

申请本细则奖补的企业、机构及组织(包括现有及新注册的)须通过横琴粤澳深度合作区惠企利民服务平台

(https://ycfz.hengqin.gov.cn)进行登记,并提交相关证明文件(如 遇登记方式发生变化,以合作区经济发展局通知为准):

- (一)在本细则生效前已经在合作区注册的企业、机构及组织,须在2025年5月30日至2025年7月30日期间进行申请奖补登记。
- (二)在本细则生效后在合作区注册的企业、机构及组织,可以在获得企业营业执照当日或之后随时进行登记。

依据本细则申请奖补的对应期间不得早于进行登记的月份。

上述企业、机构及组织如实地办公地址发生变更,须在变更之日起三十个工作日内登入平台进行更新,若企业、机构及组织逾期更新实际办公地址的,经济发展局有权采取减少或者不予拨付奖补的措施。

未按本细则规定进行申请奖补登记的企业、机构及组织不能申请本细则规定的各项扶持。

#### 第五条 申请奖补基本要求

申请奖补基本要求一:

申请本细则各项奖补的企业、机构及组织需满足对应本细则逐条规定的申请条件。

申请奖补基本要求二:

- (一)企业、机构及组织在符合"申请奖补基本要求一"的基础上,还需同时满足以下"实地研发人员人数"和"产业化投入金额"两个要求才能获得本细则对应最高额度的奖补;
- (二) 若企业、机构及组织符合"申请奖补基本要求一",但 无法同时满足"实地研发人员人数"和"产业化投入金额"两个要 求,则其可获得本细则对应最高额度奖补档位需下调至同时满足 "实地研发人员人数"和"产业化投入金额"对应的档位。

序	要求		
号	实地研发人员人数	产业化投入金额	获得奖补总金额
	不低于十人		
1	(模拟芯片设计企业:	不低于四十万元	不超过五百万元
	不低于五人)		
2	不低于二十人	· 不低于三百万元 ·	不超过一千万元
3	不低于四十人		不超过一千五百万元
4	不低于六十人		不超过两千万元
5	不低于八十人		不超过两千五百万元
6	不低于一百人		不超过三千万元
7	不低于一百二十人		可以超过三千万元

申请本细则第二十一条人才培训基地补贴、第二十五条公共服务平台补贴、第二十七条专业园区运营奖励、第二十九条"零

元创业空间"的申请单位,不受前述"实地研发人员人数"规定的限制;申请本细则第三十条行业协会补贴的申请单位,不受前述"实地研发人员人数"及"产业化投入金额"规定的限制。

第二章 企业奖励

#### 第六条 新增实缴资本奖励

对以货币方式新增实缴出资累计不低于一千万元的申请单位,按其新增实缴出资的百分之十给予一次性最高五百万元奖励。

对开展重点支持领域研发且其以货币方式新增实缴出资累 计不低于一千万元的申请单位,按其新增实缴出资的百分之十给 予最高两千万元奖励,按照四比六比例分两笔拨付。

### 第七条 新增实缴资本奖励申请条件

申请本条奖励的申请单位,应当满足以下全部条件: (一)主营业务符合《适用主营业务目录》(见附件);

- (二)近三年累计获得专业投资机构投资不低于一千万元;
- (三)实缴资本(含认缴时间)、股权投资协议签署时间应 在本细则出台后。

申请重点支持领域项目的单位,还应当分别满足以下全部条件:

- (一) 若申请单位为融资主体:
- 1.第一笔奖励申请条件:在合作区的产业化投入(不含地价) 不低于五百万元,且实地研发人员人数不少于五十人;
- 2.第二笔奖励申请条件:在该单位第一笔奖励资金到账当年,其产业化投入同比增长不低于百分之十,且实地研发人员人数同比增长不低于百分之十。
- (二)若申请单位不属于融资主体,无法满足本条第二款条件,则必须满足以下条件:
- 1.第一笔奖励申请条件: 在合作区的产业化投入(不含地价) 不低于七百五十万元, 且实地研发人员人数不少于七十五人;
- 2.第二笔奖励申请条件:在该单位第一笔奖励资金到账当年,其产业化投入同比增长不低于百分之十五,且实地研发人员人数同比增长不低于百分之十五。

每个单位仅可申请一次本条规定的奖励。对已获得过第 1/2022 号执行委员会经济发展局规范性文件《横琴粤澳深度合作 区促进集成电路产业发展若干措施实施细则》第四条奖励的单位 不得申请本条奖励。

#### 第八条 净化车间补贴

对建设净化车间,达到十万级(含)以上洁净等级标准,按每平方米二百元的标准给予一次性最高一百万元补贴。

净化车间须位于合作区范围内,按净化车间标准进行装修且达到十万级(含)以上洁净等级标准,获得国家市场监督管理总局或者中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、中国计量认证(CMA)等机构的审核认定。

#### 第九条

#### 多项目晶圆(MPW)及首轮工程流片补贴

对开展多项目晶圆 (MPW) 流片的企业或者科研机构,按 照流片费用的百分之七十给予年度最高五百万元补贴。对开展工 程产品量产前全掩膜首轮流片的企业或者科研机构,按照流片费 用的百分之五十给予年度最高三千万元补贴,其中:

- (一)对工艺制程在十四纳米及以下的,年度补贴最高二千 五百万元;
- (二)对工艺制程在二十八纳米及以下的,年度补贴最高一 千五百万元;

- (三)对车规级芯片工艺制程在九十纳米及以下的,年度补贴最高一千万元;
  - (四)对其它工艺制程的,年度补贴最高八百万元。

#### 第十条

#### 多项目晶圆(MPW)及首轮工程流片补贴申请条件

申请多项目晶圆(MPW)及首轮工程流片补贴的申请单位, 应当满足以下全部条件:

- (一)申请单位的流片合同签署日期应不早于二零二四年 一月一日;
  - (二)申请单位具有该流片芯片的自主知识产权;
- (三)以申请年上一年度当年流片回片对应的流片发票金额为基数计算当年度流片补贴,同一费用不得多年重复申请;
- (四)流片费用的补贴范围包括:掩膜版制作费、用于首轮流片的晶圆购置费(不超过 25 片晶圆)、制造端 IP 授权费、测试加工费等。不包括研发端 IP 授权费、量产后晶圆购置芯片流片费等。

### 第十一条

IP 购买、复用及研发补贴

对购买 IP 开展重点支持领域研发的企业或者科研机构, 经认定,按照其实际支出费用的百分之三十给予年度最高三百万元补贴。

对复用集成电路公共服务平台 IP 开展重点支持领域研发的企业或者科研机构,经认定,按照其实际支出费用的百分之五十给予年度最高一百万元补贴。

对从事 IP 研发的企业,按照其 IP 自投研发费用的百分之三十给予年度最高一千五百万元补贴。

#### 第十二条

#### IP 购买、复用及研发补贴申请条件

申请 IP 购买补贴的申请单位应当符合以下全部申请条件:

- (一) IP 卖方须为 IP 提供商、EDA 供应商、代工厂或者其指定的代理;
- (二) IP 买卖双方有股权关系的,须提供交易 IP 价格公允 性说明及价格真实性承诺函;
  - (三)购买的 IP 用于重点支持领域研发,须通过专家评审;
  - (四)申请单位的 IP 购买合同签署日期须在政策有效期内。申请 IP 复用补贴应当符合以下全部申请条件:
- (一)申请单位与集成电路公共服务平台签订 IP 复用协议, 且协议签署日期须在政策有效期内;

(二)申请单位复用的 IP 用于本单位重点支持领域研发, 须通过专家评审。

#### 第十三条 EDA 工具购买、租用及研发补贴

对购买 EDA 工具软件(含软件升级费用)的企业或者科研 机构,按照实际支出费用的百分之三十给予年度最高三百万元补 贴。

对租用集成电路公共服务平台 EDA 工具软件的企业或者科研机构,按照其实际支出费用的百分之五十给予年度最高三百万元补贴。

对从事 EDA 工具软件研发的企业,按照其 EDA 自投研发费用的百分之五十给予年度最高一千五百万元补贴。

### 第十四条 EDA 工具购买、租用及研发申请条件

申请 EDA 工具购买补贴的申请单位,应当符合以下全部申请条件:

- (一) EDA 工具卖方须为国内外主流 EDA 供应商;
- (二)EDA工具买卖双方有股权关系的,须提供交易EDA

工具价格公允性说明及价格真实性承诺函。

(三)申请单位的 EDA 工具购买合同签署日期须在政策有效期内。

申请 EDA 工具租用补贴的申请单位须与集成电路公共服务 平台签订 EDA 租用协议,且协议签署日期须在政策有效期内。

## 第十五条 测试验证补贴

对在合作区开展集成电路晶圆或芯片产品的功能、性能、可靠性、兼容性、失效分析等方面的检测、测试验证服务的单位,按照上一年度为澳门、合作区企业或者机构(无股权关系)提供检测、测试验证服务实际收入的百分之五十给予年度最高五百万元补贴。

对在合作区开展用于测试及检测相关设备(含核心零部件)、 耗材研发的企业,经认定,按照其自投研发费用的百分之五十给 予年度最高五百万元补贴。

#### 第十六条 制造封装补贴

对在合作区开展集成电路制造及封装相关设备(含核心零部

件、软件)研发、模组加工的企业,按照其自投研发费用的百分之二十给予年度最高一千万元补贴。

#### 第十七条 车规级认证补贴

对集成电路企业产品通过汽车电子车规级认证的,按照其实际认证费用的百分之三十给予年度最高二百万元补贴。

申请车规级认证补贴的申请单位须取得国际公认测试、检验和认证机构颁发的证书,并提供发票、支付凭证。

#### 第十八条 行业创新奖项奖励

对获评中国电子信息产业发展研究院"中国芯"奖项,中国半导体行业协会"中国半导体创新产品和技术"称号,中国集成电路创新联盟"集成电路产业技术创新奖"的企业,给予一次性三十万元奖励。

企业获得多个奖项的, 仅奖励一次。

第三章 人才奖励

#### 第十九条 人才引进奖励

对合作区集成电路企业的研发人员和高级管理人员、合作区科研机构的研发人员、与合作区企业具有关联关系的澳门公司的研发人员,按照其上一年度工资薪金收入总额,每年给予奖励,具体奖励标准如下:

- (一)年薪三十万元(含)到五十万元(不含)的,给予十万元奖励;
  - (二)年薪五十万元(含)以上的,给予十五万元奖励;

集成电路企业申请享受该条奖励的高级管理人员人数不超过企业员工总数的百分之十,且不超过十人。

申请人为澳门居民或者拥有澳门高校学士及以上学位的,奖励金额标准按照上述标准的百分之一百五十执行。

#### 第二十条 人才引进奖励申请条件

申请第十九条奖励的申请人应当满足以下全部条件:

(一)所在单位为主营业务符合《适用主营业务目录》(见附件)的合作区集成电路企业、科研机构,或者与合作区企业具

有关联关系的澳门公司;

- (二)与所在单位签订三年以上全职劳动合同,审核期间劳动合同仍在有效期内;
- (三)至申报通知发布日,在所在单位连续缴纳社保及个人 所得税(职业税)不少于六个月(退休返聘、外籍或者港澳台员 工无需社保);
- (四)申请人须在合作区企业担任研发、高级管理岗位,或者在合作区科研机构、与合作区企业具有关联关系的澳门公司担任研发岗位;
- (五)申请人是合作区集成电路企业、科研机构的员工的, 上一年度在合作区实地办公的天数不少于年度实际工作天数的 一半;申请人是与合作区企业具有关联关系的澳门公司的员工 的,上一年度在合作区或者澳门实地办公的天数不少于年度实际 工作天数的一半;
- (六)申请人在合作区集成电路企业、科研机构的年薪,以上一年度在所在单位取得并缴纳个人所得税的工资薪金所得数据核算;与合作区企业具有关联关系的澳门公司员工的年薪,以上一年度在所在公司取得的职业税收益数据核算;
- (七)同一合作区集成电路企业申请享受该条奖励的高级管理人员人数不超过该企业在合作区缴纳社保及个人所得税(退休返聘、外籍或者港澳台员工无需社保)员工总数(以上一年度十月、十一月、十二月的员工数量的月末平均数计算)的百分之十,

且不超过十人;

(八)同一申请人只能在同一单位申请本细则及第 1/2022 号执行委员会经济发展局规范性文件《横琴粤澳深度合作区促进 集成电路产业发展若干措施实施细则》所规定的人才引进奖励;

(九)本条奖励资金由人才所在单位统一申报,并发放至相应个人。与合作区企业具有关联关系的澳门公司的人才奖励,由其合作区关联公司统一申报,并发放至个人。合作区企业的澳门关联公司人才奖励总额需算入该合作区企业的"获得奖补总金额"中。

#### 第二十一条 人才培训基地补贴

对认定为合作区集成电路人才培训基地的单位,每年给予一百万元补贴。经培训基地培训后被合作区集成电路企业或者科研机构聘用的研发人员,按照三万元每人的标准给予基地年度最高一百万元奖励;

前款所称"被合作区集成电路企业或者科研机构聘用的研发人员"是指与合作区集成电路企业或者科研机构签订全职劳动合同、在所在单位连续缴纳社保及个人所得税不少于六个月,且在合作区实地办公的研发人员。

### 第二十二条 人才培训基地认定条件和程序

人才培训基地认定常年申报,按"成熟一个,认定一个"的原则进行,在本细则有效期内,合作区累计认定培训基地不超过两个。

申请人才培训基地认定的申请单位应当满足以下全部条件:

- (一)申请单位设有专门组织机构负责培训业务,部门职能和教职工岗位职责明确,建立规范的培训管理、财务管理、资产管理等制度;
- (二)基地以培养集成电路领域内的设计工程师、测试工程师、算法工程师、工艺工程师等研发人员为目的,已构建以提升学员职业能力为核心,体现专业学习和工作实践紧密结合的课程体系;
- (三)基地具备面积不低于一百五十平方米的固定培训场所 及与课程相匹配的软硬件设施;
- (四)基地拥有一支稳定的教学水平、技能操作能力等综合 素质较强的专、兼职教师队伍;
- (五)在申请认定时,已与两家及以上大、中型企业建立合作,共建培训实习基地,聘请企业专业技术人员担任指导教师。 鼓励为企业提供订单式培训。

人才培训基地按照以下程序进行认定:

- (一)申请单位提交申报材料到合作区经济发展局,由合作区经济发展局初步核查后,组织专家进行评审,确定拟认定名单并进行公示,公示期满无异议或经调查异议不成立的,由合作区经济发展局发文认定并授予"横琴粤澳深度合作区集成电路人才培训基地"牌匾;
- (二)对经认定的培训基地,合作区经济发展局每年组织专家进行一次综合评估。对评估不合格的,取消培训基地资格,停止拨付补贴、奖励资金。

# 第二十三条 企业委培补贴

对采用合作区认定的集成电路人才培训基地开展员工培训的企业或者科研机构,按照实际发生培训费用的百分之五十给予年度最高一百万元补贴。

申请企业委培补贴的申请单位应当满足以下全部条件:

- (一)申请单位为主营业务符合《适用主营业务目录》(见 附件)的企业或者科研机构;
- (二)申请单位采用合作区认定的集成电路人才培训基地开展集成电路技术技能培训;
  - (三)申请单位参加培训的人员与申请单位已签订全职劳动

合同,且属于研发岗位;

(四)申请单位与培训基地依托单位无股权关系。

## 第二十四条 实习补贴

对接收境内外高校集成电路相关专业在校学生实习的企业或者科研机构,按以下标准给予年度最高一百万元补贴:

- (一) 若实习生为非澳门居民,按每人每月五千元的标准;
- (二) 若实习生为澳门居民,按每人每月六千元的标准。

申请实习补贴的申请单位应当满足以下全部条件:

- (一)申请单位为主营业务符合《适用主营业务目录》(见 附件)的企业或者科研机构,与接收的境内外高校在校学生签订 实习协议;
- (二)实习生所学专业学科门类为理学、工学,且在申请单位研发岗位实习;
  - (三)单个实习生的实习补贴期不超过十二个月;
- (四)实习期内,实习生在合作区实地办公的天数不低于年 度实际工作天数的百分之六十。

#### 第四章 平台补贴

#### 第二十五条 公共服务平台补贴

支持企业或者机构建设集成电路产业公共服务平台,通过专业化的运营管理与服务,为企业提供中试研发、集成电路设计、EDA工具、IP共享、MPW、快速封装测试,以及集成电路产品、设备、材料的失效性和可靠性分析、测试、验证、认证等公共技术支撑,按照平台仪器设备(含软件)实际投入费用的百分之三十给予年度最高五百万元补贴。

#### 第二十六条 公共服务平台认定条件

集成电路公共服务平台认定常年申报,按"成熟一个,认定一个"的原则进行认定。

申请公共服务平台认定的申请单位应当满足以下全部条件:

- (一)具有明确的专业方向、服务目标和发展规划,为企业提供中试研发、集成电路设计、EDA工具、IP共享、MPW、快速封装测试,以及集成电路产品、设备、材料的失效性和可靠性分析、测试、验证、认证等公共技术支撑;
  - (二)具备公共服务平台运行的必要条件保障,有较强的技

术支撑能力,固定的经营服务场所和必要的仪器设备,办公场所 面积不少于一百五十平方米;

- (三)具有健全的管理制度,规范的服务流程、合理的收费 标准和完善的服务质量保证措施;
- (四)具有健全的管理团队和人才队伍,主要负责人具有丰富的实践经验和较高的管理水平,拥有对外提供技术服务的专业人才队伍。

申请公共服务平台按照以下程序进行认定:

申请单位提交申报材料到合作区经济发展局,合作区经济发展局初步核查后组织专家进行评审,确定拟认定名单并进行公示,公示期满无异议或经调查异议不成立的,由合作区经济发展局发文认定并授予牌匾。

### 第二十七条 专业园区运营奖励

自专业园区备案年度起,园区运营机构须每年组织合作区企业参与国内外集成电路专业展会不少于三场。在此基础上,每当园区增量指标满足以下条件之一时,给予园区运营机构五百万元运营奖励,同一园区运营机构在本细则有效期内最高奖励一千万元:

(一)在园区实地办公且经备案的集成电路企业,新增营业

收入(产值)十亿元;

- (二)新增在园区实地办公的企业员工不少于三百五十人, 其中研发人员不少于二百人,年薪八十万元以上的研发人员不少 于二十人;
- (三)新增获得申请单位自有或者合作的投资资金投资的园 区企业数量不少于五个。

首次申报本条奖励的申请单位,以备案当年营业收入、实地办公企业员工及研发人员数量为基数;再次申报本条奖励的单位,以上一次享受奖励时申报的数据为基数。

上述"年薪"以个人上一年度在园区入驻企业取得并缴纳个人所得税的工资薪金所得数据核算。

#### 第二十八条 专业园区备案条件

集成电路专业园区常年受理备案申请。

申请备案为集成电路专业园区的申请单位应当满足以下全部条件:

(一)申请单位运营管理的集成电路专业园区场地集中,建筑面积不低于三万平方米,以集成电路设计、制造、封装测试、设备(含核心零部件)、材料、EDA工具研发企业和相关机构为入驻对象;

- (二)在园区建设或者引进集成电路公共服务平台,可以提供研究开发、检验检测、小试中试等专业技术服务;
- (三)拥有专业的招商和服务团队,可以为入驻企业提供技术、金融、管理、商务、市场、国际合作等方面的专业服务;
- (四)具备投融资服务功能,自有种子资金或者合作的投资资金规模不低于五千万元;
- (五)申请单位须在备案通过后十五个工作日内,向合作区 经济发展局报送园区实地办公企业名单及企业员工清单、岗位证 明等材料。

#### 第二十九条 "零元创业空间"补贴

对经备案的"零元创业空间",按不超过第三方专业机构租金评估价的百分之一百,给予连续最长三十六个月的租金补贴,补贴面积最高不超过一千平方米。

"零元创业空间"常年受理备案申请。

申请"零元创业空间"备案的申请单位应当满足以下全部条件:

- (一)"零元创业空间"设立于已通过合作区经济发展局备案的集成电路专业园区内。
  - (二)场地相对集中,向入驻企业及团队、创业者免租金提

供,单个企业入驻面积不超过一百平方米,入驻时间不超过六个月。

(三)申请补贴的"零元创业空间",上一年度入驻企业数量 须不少于三十个。

每个集成电路专业园区仅可备案一个"零元创业空间"。

#### 第三十条 行业协会补贴

支持合作区内集成电路行业协会举办产业活动,对参与单位 不少于十五家、三十家、五十家的活动分别按每场两万元、四万 元、六万元给予补贴,每个行业协会每年最高补贴一百万元;

申请两万元、四万元、六万元补贴的活动对应参与人数分别不少于三十人、四十五人、六十人,且每场活动的参与单位中合作区集成电路企业占比不少于百分之七十。

第五章 粤澳协同奖励

第三十一条 联合实验室补贴

对合作区企业联合澳门高校产学研示范基地共建集成电路 领域相关联合实验室的,按照企业实际投入资金的百分之三十,给予单个联合实验室最高二百万元补贴。

### 第三十二条 联合实验室补贴申请条件

申请联合实验室补贴的申请单位应当满足以下全部条件:

- (一)申请单位为主营业务符合《适用主营业务目录》(见 附件)的企业或者科研机构;
- (二)申请单位与澳门高校产学研示范基地签订正式合作协议,明确共建联合实验室;
- (三)联合实验室应当以技术研发、成果转移转化、人才培养为核心,具有稳定而明确的长期(不低于三年)合作机制,非针对具体的一次性项目合作:
- (四)联合实验室在合作区具备固定的场地、研发人员和必要的仪器设备;
  - (五)申请单位对联合实验室已有实际投入经费。

# 第三十三条 澳资企业特别奖励

对符合本细则申请条件的澳资企业,按照本细则既定标准的百分之一百二十执行,最高金额不能超过各条款奖补上限。

## 第六章 监督管理

## 第三十四条 申报流程

除本细则另有规定外,合作区经济发展局每年安排集中受理 申请(具体时间以发布的申报通知为准),申请单位应当按要求 提出申请,逾期未申请的视为自动放弃。具体流程如下:

- (一)系统申报。申请单位根据本细则、申报通知要求,登录申报系统填写申报书并上传附件材料;
- (二) 受理。合作区经济发展局对申报材料进行初审,不符合受理条件的,不予受理;资料不全的,一次性告知对方须补齐的资料;符合受理条件且资料齐备的,准予受理;
- (三)组织审核。合作区经济发展局组织专家或者委托第三 方专业机构对申报材料的真实性、有效性等方面进行审核和实地 考察,得出审核结论;
- (四)资金审定。合作区经济发展局根据专家或者第三方专业机构审核结论,确定资金资助方案;

- (五)公示。合作区经济发展局将拟奖补名单和金额在合作 区执委会政务网站公示七个工作日;
- (六)资金拨付。公示期满无异议或者经调查异议不成立的, 由合作区经济发展局按规定拨付资金。

## 第三十五条 适用原则

申请单位在享受本细则资助的同时不影响其申请国家、广东省的其他政策扶持和优惠,但由合作区财政承担或者配套的以及另有规定的除外。

本细则与合作区以下已出台的同类政策有交叉、重复,申请 单位择一政策进行申请,不得重复申请:

- (一)已获得第 11/2024 号经济发展局规范性文件《横琴粤澳深度合作区构建优质科技创新环境实施办法》第八条奖励的单位,同一笔投资不得再申请本细则第六条新增实缴资本奖励;
- (二)已获得第 7/2024 号经济发展局规范性文件《横琴粤 澳深度合作区大力培育引进创新型成长型企业梯队实施办法》第 十条、第 9/2024 号经济发展局规范性文件《横琴粤澳深度合作区支持研发及成果转化实施办法》第八条、第 5/2024 号经济发展局规范性文件《横琴粤澳深度合作区促进与葡语系国家科技交

流合作的扶持办法》第十一条、第 1/2023 号经济发展局规范性 文件《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》 第十条、第 8/2024 号经济发展局规范性文件《横琴粤澳深度合作区产业核心和关键技术攻关项目实施办法》的研发类补贴的企业,相关费用不得再申请本细则第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十七条规定的补贴。

(三)已获得第 6/2024 号经济发展局规范性文件《横琴粤 澳深度合作区支持创新平台载体建设实施办法》第七条资助的联 合实验室项目不得重复申请本细则第三十一条规定的资助。

本细则中涉及"补贴"相关条款仅适用于申请单位使用自有资金(含政府股权投资,但不含企业所获得的合作区无偿资助类财政资金)建设的内容,若使用合作区政府无偿资助类财政资金支持的不得再申请"补贴"相关条款扶持。

# 第三十六条 资金来源

本细则所需资金实行预算管理,按年度在合作区专项资金预 算中安排。

第三十七条 资金监督

各申请单位应对申报材料的真实性和合法性负责。申请单位 提供虚假材料骗取奖补资金的,取消其申请资格并追缴奖补资 金,禁止其在本细则有效期内再次申请奖补资金,并按相关法律 法规规定严肃查处。

本细则所涉及的奖补均为税前标准,获得奖补资金的单位和 个人须按相关规定履行纳税义务。

第七章 附则

第三十八条 解释部门

本细则由合作区经济发展局负责解释。

#### 第三十九条 施行日期和有效期

本细则自 2025 年 1 月 1 日起实施,有效期至 2027 年 12 月 31 日。

#### 适用主营业务目录

- 1.设计及支撑工具。主要包括集成电路及半导体产品设计及服务,芯片设计平台(EDA工具)及配套 IP 库;
- 2.制造。主要包括线宽九十纳米及以下大规模数字集成电路制造,零点五微米及以下特色工艺集成电路或半导体器件制造, TFT 半导体器件制造;
- 3.封装测试。主要包括晶圆级封装、系统级封装(SiP)、芯片级封装(CSP)、圆片级封装(WLP)、倒装封装(Flip Chip)、球栅阵列封装(BGA)、硅通孔(TSV)、三维封装(3D)、Chiplet(芯粒)、FOG(软排线对TFT玻璃板)等先进封装和测试技术的开发及产业化;
- 4.材料。主要包括八英寸/十二英寸集成电路硅片、绝缘体上硅(SOI)、SiC、GaN、Pyrex glass(无碱硼硅玻璃)等化合物半导体材料,光刻胶、靶材、电子特气、抛光及研磨材料、封装材料等;
- 5.设备及零部件。主要包括半导体前道制造设备(含软件)、 后道封装及测试设备(含软件)以及其他半导体设备(含软件) 及关键零部件。

公开方式: 主动公开

横琴粤澳深度合作区经济发展局

2025年5月30日印发